

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Российский химико-технологический университет имени  
Д.И. Менделеева»**

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по науке  
РХТУ им. Д.И. Менделеева



*А.А. Щербина*  
«13» *декабря* 20 *22* г.

**ПРОГРАММА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА  
ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ**

**2.2.3. ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА  
МАТЕРИАЛОВ И  
ПРИБОРОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ**

Москва 2022 г

Программа составлена д.х.н., профессором, заведующим кафедрой химии и технологии кристаллов И.Х. Аветисовым, д.х.н., профессором кафедры химии и технологии кристаллов О.Б. Петровой, к.т.н., доцентом кафедры химии и технологии кристаллов К.А. Субботиным и к.х.н., доцентом кафедры химии и технологии кристаллов И.В. Степановой.

## СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

### **Раздел 1. Физическая химия идеального и реального кристалла.**

**1.1. Основы кристаллографии.** Симметрия кристаллов и анизотропия их свойств. Атомные и ионные радиусы. Химическая связь. Соотношение ионных радиусов и структура кристаллов. Типы структур кристаллов.

Структура и симметрия идеальных и реальных кристаллов; основные типы дефектов кристаллической структуры. Политипизм и полиморфизм. Термодинамика дефектов кристаллической решетки. Собственные и примесные дефекты в элементарном кристалле; точечные и протяженные дефекты. Температурная зависимость равновесных концентраций дефектов. Влияние дефектов на физические и химические свойства кристаллов - параметры решетки, плотность, пластичность, диффузию, электропроводность, оптические и магнитные свойства, теплопроводность, теплоемкость, коррозионную устойчивость и др.

**1.2. Дефекты, вызванные инородными примесями.** Влияние примесей на равновесие собственных дефектов. Физико-химические основы процессов легирования. Изменение валентности примесных ионов. Взаимосвязь ионной и электронной разупорядоченности в кристаллах. Взаимное влияние примесей на их растворимость в кристаллической фазе. Современные методы исследования концентрации и распределения дефектов, вызванных нарушениями стехиометрии кристалла. Взаимодействие дефектов.

**1.3. Механизмы диффузии.** Элементы математического описания диффузионных процессов. Особенности, диффузии по вакансиям, дислокациям и по поверхности кристаллов. Связь между подвижностью носителей заряда и коэффициентом диффузии. Проявление зависимости: электропроводность - концентрация дефектов - давление - температура. Процессы, контролируемые дефектами при спекании кристаллов. Кинетика гетерогенных процессов и ее методы в технологии получения кристаллов с дефектами. Основные закономерности топохимических реакций. Методы определения кинетических констант.

Дифракция в кристаллах и обратная решетка; упругие колебания в кристаллах, оптические и акустические фононы; тепловые свойства кристаллов; модель свободных электронов, основы зонной теории, классификация твердых тел, статистика электронов.

**Раздел 2. Электрические, оптические и магнитные процессы и явления в кристаллах.**



**2.1. Электрические свойства металлов, диэлектриков и полупроводников.** Зонная теория идеальных и реальных полупроводников. Основные определения. Зонная структура энергетического спектра носителей заряда. Распределение Ферми-Дирака. Электропроводность металлов, полупроводников и диэлектриков и их физическая природа. Собственные и примесные полупроводники. Доноры, акцепторы, глубокие центры. Диффузия и дрейф носителей, генерация и рекомбинация, электронно-дырочный переход; поверхностные электронные состояния, эффект поля.

**2.2. Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниках.** Поглощение и отражение света. Эффект Фарадея. Фотопроводимость. Фотоэффект. Эмиссия света из полупроводников. Межзонная излучательная, безизлучательная и ударная рекомбинация. Катодо-, фото- и электролюминесценция. Излучательная рекомбинация. Когерентное излучение. Поверхностные состояния в полупроводниках; слои обогащения, инверсии и обеднения. Полупроводники в сильном электрическом поле. Влияние сильного электрического поля на подвижность носителей заряда. Эффект Франца-Келдыша. Эффект Ганна.

**2.3. Поляризация диэлектриков и ее физическая сущность.** неполярные и полярные диэлектрики. Проводимость диэлектриков и ее физическая природа. Диэлектрические потери и их природа. сегнетоэлектричество, пьезо- и пьезоэлектричество.

**2.4. Магнитные свойства твердых тел.** Ферромагнетизм, сверхпроводимость

**Раздел 3. Современные теории зародышеобразования и роста кристаллов.**

**3.1. Элементарные процессы зародышеобразования и роста кристаллов.** Существующие теории роста на атомногладкой и атомношероховатой поверхности, теории нормального и непрерывного роста. Теоретические основы кристаллизационных методов очистки и выращивания монокристаллов.

**3.2. Гетерогенные равновесия.** Условия стабильности и равновесия фаз. Типы диаграмм фазовых равновесий двух- и многокомпонентных систем. Диаграммы как источник информации необходимой для выбора и оптимизации метода синтеза материалов с заданным составом и свойствами, определение условий их стабильного существования.

**3.3. Понятие о фазах переменного состава.** Явление нестехиометрии. Отображение явлений нестехиометрии на диаграммах состояния. Р-Т-Х - диаграмма, как источник информации для получения кристаллов с заданным отклонением от стехиометрии.

**3.4. Основные принципы термодинамики неравновесных процессов.** Термодинамика неравновесных процессов в технологии материалов электронной техники. Характеристика открытых и непрерывных систем. Составление материальных и энергетических балансов. Стационарные состояния в непрерывных системах. Истолкование процессов кристаллизации с позиций неравновесной термодинамики.

**Раздел 4. Физическая химия высокодисперсных систем, поверхностные явления.**



#### **4.1. Основы физической химии высокодисперсных систем.**

Принципы создания наноконпозиционных материалов. Термодинамическая стабильность наноразмерных материалов. Фазовые и структурные переходы в сверхтонких (поверхностных) системах. Теория зародышеобразования при формировании новой фазы на поверхности и в объеме твердого тела. Образование дисперсных структур на поверхности и в объеме при эпитаксии, ионной имплантации и термообработке.

**4.2. Поверхность как особая область твердого тела.** Идеальная и реальная поверхность твердого тела. Структурно-механические свойства поверхности: микро- и наношероховатость, микро- и нанопористость, микротрещины, краевые и винтовые дислокации, точечные дефекты; триботехнические характеристики поверхности, коэффициент трения скольжения, износостойкость, антифрикционные слои. Электрофизические свойства поверхности: зарядовые состояния, встроенный и индуцированный заряды, электростатическое взаимодействие заряженных поверхностей; поверхностно-активные вещества; термоэлектронная, электронная и ионно-полевая эмиссии; электромагнитное взаимодействие, электромагнитная индукция, токи индуцированные электромагнитными полями, скин-эффект. Проявление размерных эффектов и эффектов масштабирования при электростатических и электромагнитных взаимодействиях.

### **Раздел 5. Кинетическая теория газов, физика плазмы.**

**5.1. Основы кинетической теории газов.** Распределение Максвелла-Больцмана. Средние значения скорости движения, длины свободного пробега и числа столкновений молекул. Явления переноса. Режимы течения газов. Вакуум, методы получения и измерения. Испарение. Зависимость давления насыщенных паров от температуры. Газовый разряд. Ионизация газов, ионизационный потенциал. Рекомбинация. ВАХ несамостоятельного разряда. Тлеющий, дуговой, искровой и коронный разряды. Плазма и ее свойства. Характеристики плазмы (изотермичная, неизотермичная, равновесная, неравновесная, высоко-, низкотемпературная, идеальная, неидеальная). Ионизованный газ и плазма; элементарные процессы в плазме и на пограничных поверхностях; основные методы генерации плазмы; модели для описания свойств плазмы; типы газовых разрядов; общие свойства плазмы: явления переноса, плазма в магнитном поле, колебания, неустойчивости и эмиссионные свойства плазмы, излучение плазмы.

**5.2. Физика процессов генерации плазмы в газовых разрядах:** тлеющем, дуговом, высокочастотном (ВЧ) и сверхвысокочастотном (СВЧ). Разряды во внешнем магнитном поле, движение частиц в плазме. Взаимосвязь между рабочими, технологическими и конструктивными параметрами разрядных систем. Математические модели процессов и устройств, вольт-амперные характеристики разрядов.

**5.3. Электронная эмиссия.** Основы электронной теории твердого тела, термоэлектронная, автоэлектронная, взрывная, вторично-электронная, фотоэлектронная эмиссия. Электронный поток, его формирование и транспортировка: интенсивные и неинтенсивные, релятивистские и нерелятивистские электронные потоки



## **Раздел 6. Материалы электронной техники и технологии их получения**

**6.1. Общая классификация материалов по составу, свойствам и техническому назначению.** Физическая природа электропроводности металлов, сплавов, полупроводников, диэлектриков и композиционных материалов; сверхпроводящие металлы и сплавы; характеристика проводящих и резистивных материалов во взаимосвязи с их применением в электронной технике.

**6.2. Элементарные полупроводники.** Физико-химические, электрофизические и оптические свойства. Современные методы выращивания монокристаллов элементарных полупроводников. Принципы выращивания структурно совершенных монокристаллов. Микродефекты в монокристаллах кремния.

**6.3. Полупроводниковые соединения  $A^{III}B^V$ .** Физико-химические, электрофизические и оптические свойства. Синтез и выращивание объемных монокристаллов соединений  $A^{III}B^V$  в связи с Р-Т-Х диаграммами. Методы кристаллизации и легирования. Тройные диаграммы состояния  $A^{III}B^V$  – примесь. Компенсация и получение полуизолирующих кристаллов. Специфика подготовки подложек различных соединений  $A^{III}B^V$ . Влияние кристаллографических ориентаций. Травление жидкостное, расплавное, газовое.

Получение широкозонных материалов – нитриды галлия, алюминия, бора. Эпитаксия арсенида галлия, фосфида галлия, арсенида индия, антимонида индия и твердых растворов. Применение соединений  $A^{III}B^V$  в СВЧ-технике, оптоэлектронике, квантовой электронике.

**6.4. Полупроводниковые соединения  $A^{II}B^{VI}$  и  $A^{IV}B^{VI}$ .** Физико-химические, электрофизические и оптические свойства. Синтез и выращивание монокристаллов соединений с двумя летучими компонентами. Методы выращивания монокристаллов из газовой фазы и из расплава. Эпитаксия соединений. Методы управления стехиометрическим составом. Термообработка. Особенности получения соединений: сульфида кадмия, селенида кадмия, теллурида кадмия, сульфида свинца, твердых растворов. Области применения кристаллов: лазеры, оптические модуляторы, акустоэлектронные приборы, ИК-фотоприемники.

**6.5. Аморфные полупроводники.** Аморфный кремний и сплавы на его основе. Применение аморфного кремния в фотоэлектрических преобразователях. Понятие о физико-химических механизмах переключения памяти и оптической записи информации в халькогенидных стеклах. Особенности стеклообразования в халькогенидных системах и в оксидных системах. Синтез стеклообразных полупроводников и их свойства.

**6.6. Материалы вакуумной электроники.** Требования к чистоте материалов и их газосодержанию. Основные требования, предъявляемые к материалам для получения вакуумплотных соединений. Особенности технологии изготовления корпусов ИС на основе металлов и стекловидных материалов: стекол, ситаллов и композиционных материалов.

## **Раздел 7. Материалы оптоэлектроники.**



**7.1. Излучательные свойства твердых тех.** Излучение света в полупроводниках. Полупроводники с прямой и непрямой запрещенной зоной. Иттрий-алюминиевый гранат: структура, важнейшие физические свойства. Диаграмма плавкости и факторы, благоприятствующие кристаллизации гранатовой фазы. Методы выращивания, характерные ростовые дефекты и методы борьбы с ними. Термодиффузионное получение композитных активных элементов. Лазерная керамика на основе иттрий-алюминиевого граната. Прочие упорядоченные кристаллические матрицы для редкоземельных ионов (алюминат иттрия, ванадаты, сесквиоксиды и лазерная керамика на их основе). Разупорядоченные кристаллические матрицы для редкоземельных ионов, а также лазерные стекла и волокна.

**7.2. Лазерные кристаллы, легированные переходными 3d-ионами** ( $Ti^{3+}:Al_2O_3$ ,  $Cr^{3+}:BeAl_2O_4$ ,  $Cr^{4+}:Y_3Al_5O_{12}$ ,  $Cr^{4+}:Mg_2SiO_4$ ), а также кристаллы для пассивных лазерных затворов ( $V^{3+}:Y_3Al_5O_{12}$ ,  $Co^{2+}:MgAl_2O_4$ ): структура, физико-химические и спектрально-генерационные характеристики, особенности выращивания монокристаллов. Проблемы управления зарядовым состоянием ионов-активаторов.

**7.3. Самоактивированные и примесно-активированные люминофоры.** Активаторные примеси для люминофоров и сцинтилляторов, требования, предъявляемые к ним. Требования, предъявляемые к люминофорным и сцинтилляторным матрицам. Монокристаллы вольфрамата свинца. Физико-химические и эксплуатационные свойства. Получение монокристаллов. Типичные дефекты. Техника безопасности. Щелочно-галогенидные сцинтилляторные кристаллы, структура и свойства, выращивание крупных кристаллов, области применения. Монокристаллы фторида церия. Физико-химические и эксплуатационные свойства. Методы получения кристаллов. Влияние атмосферы на качество кристаллов. Тигельные материалы. Типичные дефекты. Техника безопасности. Области применения. Краткий обзор современных порошкообразных люминофоров. Основные методы их синтеза.

**7.4. Лазерные кристаллы фторидов.** Общие отличительные особенности физико-химических и спектрально-люминесцентных свойств, преимущества и недостатки по сравнению с оксидными кристаллами. Проблемы технологии получения высокопрозрачных монокристаллов и методы глубокой очистки ростовой зоны от воды и кислорода. Фторидные оптические кристаллы со структурами поваренной соли, флюорита, шеелита и кордиерита. Фторидная лазерная керамика и нано-стеклокерамика.

**7.5. Ниобат лития.** Структура и фазовые превращения, физико-химические характеристики, фазовая диаграмма и особенности технологии выращивания кристаллов. Конгруэнтные и стехиометрические кристаллы  $LiNbO_3$ . Технологические дефекты и возможности их устранения. Доменное строение, кристаллы с регулярной доменной структурой и их применение, монодоменизация кристаллов. Специфика  $LiTaO_3$ . Монокристаллы калий-титанил-фосфата. Состав, фазовые переходы, структура и основные физико-химические свойства. Выращивание кристаллов из раствора в расплаве. Области применения и проблема «серых треков». Краткий обзор других нелинейно-оптических кристаллов ( $BBO$ ,  $LBO$ ,  $KDP$ ).



**7.6. Пьезо- и сегнетоэлектрики.** Особенности структуры и сегнетоэлектрический фазовый переход. Кварц. Структура, полиморфные модификации, физико-химические свойства кварца. Выращивание крупных монокристаллов гидротермальным методом, работа в "перевернутом" и рабочем режимах. Технологические параметры, оказывающие наибольшее влияние на скорость роста и качество монокристаллов. Области применения кристаллов. Лангасит как альтернатива синтетическому кварцу. Структура, свойства и выращивание кристаллов. Краткий обзор других пьезо- и сегнетоэлектрических кристаллов. Монокристаллы ниобата бария-натрия и ниобата бария-стронция как электрооптические и фоторефрактивные материалы: физико-химические свойства, структура полиморфных модификаций. Диаграммы плавкости систем, монокристаллы конгруэнтного и стехиометрического SBN, их преимущества, недостатки и особенности выращивания, области применения.

**7.7. Ферриты со структурой шпинели, граната, перовскита и гексаплюмбита.** Би- и полиферриты. Основные методы получения кристаллов ферритов. Физико-химические характеристики и методы получения монокристаллов железо-иттриевого граната. Дефекты в кристаллах. Получение монокристаллических эпитаксиальных пленок железо-иттриевого граната. Основные области применения ферритов. Магнитооптические изоляторы на фарадеевском эффекте. Монокристаллы ТГГ и ТСАГ, физико-химические свойства и особенности выращивания.

**7.8. Корунд как важнейший функциональный и подложечный монокристалл.** Основные физико-химические свойства, структура. Выращивание кристаллов методами Чохральского и Багдасарова, их достоинства и недостатки применительно к технологии корунда. Проблема тигельного материала. Получение очень крупных кристаллов корунда методом ГОИ. Получение кристаллов различных форм методом Степанова. Дефекты в кристаллах, методы их контроля и способы устранения. Фианит, его основные свойства и сферы применения. Структурные модификации и способы их стабилизации, ЧСЦ. Выращивание кристаллов методом холодного контейнера. Краткий обзор других функциональных и подложечных материалов. Материалы акустоэлектроники. Пьезоэлектрики. Пьезоэлектрические свойства монокристаллов и текстурированных материалов. Сегнетоэлектрики.

## **Раздел 8. Наноматериалы.**

**8.1. Современные технологические методы формирования наноструктурированных материалов.** Методы литографии высокого разрешения. Эпитаксиальные методы. Электрохимические методы. Золь-гель технология. Методы молекулярного наслаивания.

**8.2. Органические материалы в электронной технике.** Органические полимерные диэлектрики. Материалы для органических светоизлучающих диодных структур (ОСИД). Применение металлоорганических соединений (МОС) в микроэлектронике. Применение металлоорганических соединений для получения чистых металлов, диэлектрических пленок, полупроводниковых соединений.



**8.3. Неорганические стекловидные диэлектрики в электронной технике и в микро-электронике.** Требования к диэлектрикам различного назначения и области их применения: подложки, материалы для бескорпусной защиты, пассивации, герметизации ИС, межслойной и межкомпонентной изоляции ИС, трехмерных структур, структур «кремний на изоляторе», изоляции электродов газоразрядных индикаторных панелей, элементов интегральной оптики и акустоэлектроники.

**8.4. Сверхпроводящие материалы.** Кристаллическая структура и изотипический эффект. Эффект Джозефсона. Высокотемпературные керамические сверхпроводники. Технология изготовления.

**8.5. Особо чистые элементы и материалы, их роль в современной технике.** Понятие о чистоте вещества, методы определения и оценка чистоты. Физико-химические основы глубокой очистки веществ. Понятие о коэффициенте разделения и распределения. Методы очистки. Зонная очистка. Сублимация. Ректификация. Хроматографическая очистка. Экстракция, Электролиз. Методы получения гидридов, хлоридов металлов и металлоорганических соединений. Фоторезисты. Определение и классификация. Требования к фоторезистам. Электронрезисты и рентгенрезисты.

## **Раздел 9. Технология получения структур микроэлектроники**

**9.1. Методы эпитаксии кремния из газовой фазы. Легирование и автолегирование.** Особенности выращивания структур со скрытыми слоями. Газофазная эпитаксия. Хлоридный, хлоридно-гидридный и МОС-гидридный методы. Жидкостная эпитаксия и области ее применения. Механизм кристаллизации из раствора в расплаве. Фазовое равновесие. Равновесная и неравновесная кристаллизация. Коэффициент распределения примесей. Молекулярно-лучевая эпитаксия.

Структуры для СВЧ-транзисторов, диодов Ганна и Шоттки. Особенности получения тонких слоев с заданной неоднородностью распределения примесей.

Структуры со скрытыми слоями. Получение структур с диэлектрическими и поликристаллическими слоями.

**9.2. Структуры «кремний на изоляторе» (КНИ).** Методы прямого и непрямого сращивания для формирования структур КНИ. Глубокая имплантация ионов кислорода и азота. Дефекты в ионно-имплантированных структурах КНИ. Формирование КНИ-структур методом окисления пористого кремния. Технология получения гетерослоев кремния на сапфире. Особенности получения и электрофизические свойства слоев.

**9.3. Структуры полупроводник-диэлектрик.** Методы получения и основные электрофизические свойства структур диэлектрик-германий. Структуры диэлектрик – антимоноид индия. Технология получения структур электрохимическим окислением. Электрофизические свойства структур. Основные нестабильности и методы их уменьшения.

**9.4. Структуры оптоэлектроники.** Технология получения гетероструктур для лазеров и светодиодов. Планарные и канальные оптические волноводы. Особенности получения многослойных структур. Технология получения структур для солнечных батарей.



**9.5. Процессы пленочных технологий.** Приготовление порошков и паст для проводников и резисторов на основе палладия, серебра, золота, рутения, иридия, кадмия. Получение резисторов на основе окислов редких металлов, боридов, карбидов и нитридов. Приготовление порошков и диэлектрических паст на основе титанатов бария, кальция, висмута и др.

Методы нанесения тонких пленок в вакууме: вакуум-термический, термоионный, электронно-лучевой, ионно-плазменный (с использованием разрядов на постоянном токе (ПТ), а также ВЧ и СВЧ разрядов), с помощью автономных ионных источников. Магнетронные распылительные системы.

Процесс ионного распыления материалов. Особенности распыления металлов и диэлектриков. Зависимость коэффициентов распыления различных факторов. Закономерности удаления материала с распыляемой поверхности и особенности их использования в технологических процессах микроэлектронного производства. Применение ионно-плазменных распылительных систем для нанесения и травления материалов.

**9.6. Активные индикаторы.** Электронно-лучевые трубки, светоизлучающие диоды, электролюминесцентные, газоразрядные индикаторы и др. Пассивные индикаторы. Жидкокристаллические, электрохромные индикаторы, индикаторы на PLZT- керамике и др. Сравнительные характеристики активных и пассивных индикаторов. Жидкокристаллические материалы. Основные электрооптические эффекты в жидких кристаллах.

**9.7. Нанотехнология.** Современные технологические методы формирования нано- структур. Процессы самоорганизации и самоформирования в технологии нано- структур. Проблемы создания упорядоченных наноструктурированных материалов на большой площади.

**Раздел 10. Методы исследования материалов и элементов электронной техники**

**10.1. Методы измерения электрических параметров полупроводников.** Измерение подвижности, удельного сопротивления, концентрации носителей, доноров и акцепторов. Способы измерения толщины эпитаксиальных слоев. Характеристики однородности электрических свойств слоев на площади и толщине. Методы определения профиля распределения легирующих примесей. Измерение электрофизических параметров структур диэлектрик-полупроводник методом вольтфарадных характеристик.

**10.2. Методы исследования реальной структуры кристаллов,** определения фазового состава, прецизионного измерения параметров решетки. Методы изучения объемных дефектов. Дифракция медленных электронов. Обратное рассеяние ионов.

Исследование строения поверхностных слоев монокристаллов. Метод Берга- Барретта. Оценка совершенства кристаллов с помощью двухкристального спектрометра. Методы просвечивающей и сканирующей электронной микроскопии и примеры ее использования.

Оптические методы металлографических исследований. Наблюдение объектов в поляризованном свете. Топография поверхности. Наблюдение микродефектов поверхности эпитаксиальных слоев. Принципы двухлучевой



и многолучевой интерферометрии и их применение. Выявление дислокаций методом травления. Механизм формирования ямок травления на дислокациях.

**10.3. Методы определения химического состава.** Химические методы анализа: экстракция, хроматография, полярография, потенциометрия. Объемный анализ. Гравиметрия. Спектральный анализ. Атомно-адсорбционный анализ. Люминесцентный метод. Молекулярная спектроскопия. Электронный парамагнитный резонанс, ядерный парамагнитный резонанс. Нейтронно-активационный анализ. Метод радиоактивных индикаторов, Оже-спектроскопия, рентгено-флуоресцентный анализ, лазерная и вторично-ионная масс-спектроскопия.

**10.4. Методы определения деформаций в структурах микроэлектроники.** Определение тензора деформаций с помощью двукристалльной рентгеновской дифрактометрии. Полярография. Определение деформаций по прогибу пластин.

**10.5. Методы исследования наноструктур.** Электронная микроскопия. Оптика ближнего поля. Туннельная и атомно-силовая микроскопия.

**Раздел 11. Технология и оборудование производства изделий электронной техники**

**11.1. Современные тенденции развития технологии СБИС и УБИС.** Нанотехнология. Основные требования технологии к разрабатываемому технологическому оборудованию (ТО), направления развития ТО. Методы проектирования технологического оборудования для получения субмикронных и наноразмерных структур. Системный подход к выбору оптимальных технических решений методами моделирования и формально эвристического проектирования.

**11.2. Обеспечение и поддержание в чистых помещениях среды с заданными параметрами.** Проблема привносимой дефектности при производстве СБИС. Экологические аспекты субмикронной и нанотехнологии. Модели выхода годных СБИС. Принципы организации чистых производственных помещений. Создание средств технологической экологии при производстве СБИС и УБИС. Транспортные и загрузочные системы микроэлектроники (подвижные работы, туннельно-трековые системы, системы со стандартным механическим интерфейсом (СМИФ)). Кластерный принцип организации полупроводникового производства.

Методы очистки исходных материалов и структур; оборудование, применяемое для очистки.

**11.3. Технология и оборудование для выращивания монокристаллов.** Особенности конструктивного выполнения ТО и его основных узлов и систем. Особенности выращивания из расплава элементарных полупроводников. Оптимизация равномерного распределения легирующих примесей в монокристаллах. Технология и оборудование получения полупроводникового кремния и германия. Выращивание монокристаллов германия и кремния с совершенной структурой.



Особенности технологии полупроводниковых соединений. Методы контроля и стабилизации параметров процесса выращивания монокристаллов, система автоматического управления процессом.

**11.4. Технология и оборудование для получения тонких пленок в вакууме:** вакуум-термическое испарение, электронно-лучевое испарения, высокочастотное распыление диэлектриков, ПТ и ВЧ магнетронное распыление, реактивное ионное распыление, Осаждение пленок в плазме из парогазовых смесей. Особенности проектирования, расчета и моделирования узлов и систем технологического оборудования нанесения пленок. Методы и оборудование осаждения пленок сложного состава, реактивное распыление материалов.

**11.5. Технология и оборудование для получения эпитаксиальных слоев.** Принципиальные схемы проведения эпитаксиальных процессов. Промышленные методы эпитаксиального наращивания и виды применяемого оборудования. Эпитаксия при пониженных давлениях, молекулярно – лучевая эпитаксия. Технические требования, предъявляемые к оборудованию. Типы промышленных установок. Методы контроля и стабилизации параметров эпитаксиальных процессов. Микропроцессорное управление процессами эпитаксии. Моделирование работы эпитаксиального оборудования. Алгоритмы и программы расчета и моделирование процесса и основных элементов ТО эпитаксии.

**11.6. Технология и оборудование для создания р-п переходов.** Методы получения р-п переходов, гетеропереходов и переходов металл—полупроводник. Диффузионные методы легирования. Ионное легирование (имплантация). Оборудование для процессов ионной имплантации.

**11.7. Основы технологии сварки и пайки.** Методы получения вакуумноплотных соединений. Клеевые соединения. Методы контроля герметичности. Оборудование для создания межсоединений и герметизации готовых приборов. Пластмассовая герметизация полупроводниковых приборов, ИМС. Методы пассивации и защиты полупроводниковых приборов и ИМС. Технология и оборудование для пластмассовой герметизации ИЭТ.

Методы и технология откачки и газозаполнения электровакуумных и газоразрядных приборов. Откачка удалением и связыванием. Криогенная откачка. Вакуумное технологическое оборудование для формирования остаточной вакуумной среды в электронных приборах.

Основные требования технологических процессов сварки и пайки к ТО сборки монтажа микросхем. Конструктивное выполнение установок, основных узлов и систем. Принципы расчета и проектирования узлов монтажно-сборочного оборудования. Критерии подобия сварочных процессов и их применения при проектировании оборудования.

**11.8. Термохимическое оборудование в производстве электровакуумных в полупроводниковых приборов.** Электротермические устройства и системы. Принципы расчета и проектирования. Оборудование для получения диффузионных и диэлектрических слоев в термопечах. Требования процессов диффузии, окисления и осаждения из паро-газовых смесей к ТО. Особенности конструкций компонентов: термопечей, элементов



газо-вакуумных систем, устройств утилизации продуктов реакций и др. Основы инженерного расчета газовых систем. Автоматическое управление диффузионной печью. Моделирование процессов и устройств получения диффузионных диэлектрических слоев.

Методы и оборудование травления микроструктур: ионное, реактивное ионное и плазмохимическое с использованием постоянного тока, ВЧ и СВЧ разрядов. Физика процессов, особенности проектирования и моделирования процессов, узлов и систем ТО. Системы с электронно-циклотронным резонансом. Методы анизотропного травления полупроводников (Bosh-процесс, ICP-процесс).

**11.9. Технология и оборудование электрофизических и электрохимических методов обработки.** Прецизионное электроэрозионное оборудование для обработки деталей электронных приборов. Ультразвуковое оборудование для очистки поверхности и обработки хрупких материалов. Оборудование для обработки лучом лазера. Технология и оборудование электрохимической обработки.

Современное аналитическое вакуумное оборудование. Методы получения высокого вакуума. Вторично-ионные масс-спектрометры, Оже-спектрометры, оборудование, использующее рентгеновское и лазерное излучение.

**11.10. Литографические процессы в производстве полупроводниковых приборов.** Анализ точности литографического процесса и определение требований к ТО. Сопоставительный анализ предельных возможностей процессов и ТО литографии, основанных на применении ультрафиолетового, лазерного и рентгеновского излучений, электронных и ионных пучков. Схемы процессов проектирования и формирования изображений на пластинах в производстве интегральных микросхем.

Оборудование оптической литографии (генераторы изображений, фотоповторители, установки совмещения и экспонирования и др.). Влияние дифракции и аберраций оптических систем на качество изображения. Методы машинного расчета влияния аберраций. Прецизионные системы координатных перемещений. Алгоритмы и программы расчета оптических систем и систем координатных перемещений.

Электронная литография. Классификация и принципиальные схемы электронно-лучевых и проекционных установок электронной литографии. Влияние различных факторов на качество изображения: аберраций, рассеяния электронов, эффектов близости и т.д. Конструкции, методы проектирования, расчета и моделирования основных узлов ТО электронной литографии: электронных пушек, систем формирования, переноса и отклонения пучков, систем совмещения, систем перемещения и позиционирования пластин. Современные проблемы и тенденции развития ТО электронной литографии.

Ионно-лучевая литография (ИЛЛ). Направления развития ТО ИЛЛ и особенности создания систем экспонирования коллимированным ионным пучком (ИП), острое/фокусированным ИП и систем модульной ионной проекции изображения. Конструкции, сравнительные характеристики,



методы расчета и моделирования основных узлов и систем ТО ИЛЛ: ионных источников, отклоняющих и сканирующих систем, систем ускорения и фокусировки.

**Вопросы для кандидатского экзамена по научной специальности**  
**2.2.3. Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники**

1. Оборудование для выращивания кристаллов: высокотемпературные ростовые системы с резистивным и индукционным нагревом; высокотемпературные ростовые системы с контролируемой атмосферой.
2. Зонная теория твердого тела. Энергетические спектры электронов в металлах, полупроводниках, диэлектриках. Зона проводимости и валентная зона. Эффективная масса электрона и дырки. Собственные и примесные полупроводники. Роль донорных и акцепторных примесей.
3. Спонтанные и вынужденные переходы. Коэффициенты Эйнштейна. Инверсная заселенность. Методы создания инверсной заселенности. Оптический квантовый генератор. Трехуровневая схема. Четырехуровневая схема. Основные части лазера. Возможные потери энергии в лазере. Непрерывные и импульсные лазеры. Оптические затворы. Моды излучения. Перестройка длины волны лазера. Классификация лазеров.
4. Методы и оборудование для выращивания монокристаллов. Особенности выращивания из расплава элементарных полупроводников. Оптимизация равномерного распределения легирующих примесей в монокристаллах.
5. Методы анализа материалов электроники: термические методы, оптическая спектроскопия, спектроскопия комбинационного рассеяния, рентгеноструктурный анализ, методы анализа состава и микропримесей, электронная микроскопия.
6. Устройство оптоволоконного световода. Основные параметры световода. Спектральная зависимость потерь в световоде. Виды оптоволоконных световодов и области их применения. Световоды среднего ИК-диапазона.
7. Исходные вещества, используемые для производства монокристаллов и пленок. Особо чистые вещества и материалы, их роль в современной технике. Понятие о чистоте вещества, методы определения и оценка чистоты. Физико-химические основы и методы глубокой очистки веществ. Понятие о коэффициенте разделения и распределения.
8. Электропроводность полупроводников. Поведение свободных носителей заряда в слабом электрическом поле. Взаимодействие с фононами, примесными атомами, дефектами. Подвижность электронов и дырок. Условие электронейтральности. Диффузия и дрейф носителей заряда. Соотношение Эйнштейна. Свободные носители заряда в



- сильном электрическом поле. Горячие электроны. Лавинное умножение в полупроводниках. Эффект Ганна.
9. Сравнительный анализ методов нанесения тонких пленок в вакууме. Особенности получения наноразмерных пленок органических и неорганических веществ.
  10. Полупроводниковые соединения  $A^{III}B^V$ ,  $A^{II}B^{VI}$  и  $A^{IV}B^{VI}$ : получение монокристаллов и эпитаксиальных пленок на их основе и области их применения.
  11. Неорганические и органические материалы для светоизлучающих приборов, приборов передачи и отображения информации.
  12. Методы исследования реальной структуры кристаллов. Методы оценки структурного совершенства кристаллов. Методы исследования наноструктур: электронная микроскопия, оптика ближнего поля; туннельная и атомно-силовая микроскопии.
  13. Методы и технологии создания контролируемой газовой атмосферы, в том числе при пониженном давлении, в электровакуумных и газоразрядных приборах. Вакуумное технологическое оборудование для формирования остаточной вакуумной среды в электронных приборах.
  14. Принципы организации чистых производственных помещений при производстве материалов и изделий электронной техники. Кластерный принцип организации полупроводникового производства
  15. Сверхпроводящие материалы. Технология изготовления высокотемпературных сверхпроводящих материалов и области их применения для изделий электронной техники
  16. Ниобат лития: Структура и фазовые превращения, физико-химические характеристики. Доменное строение, кристаллы с регулярной доменной структурой и их применение, монодоменизация кристаллов. Фазовая диаграмма ниобата лития и особенности технологии выращивания кристаллов.
  17. Выращивание кристаллов из растворов в расплаве на примере калий-титанил-фосфата, бората бария или бората лития. Составы и требования к растворителям. Фазовые диаграммы и выращивание кристаллов из раствора в расплаве.
  18. Кварц. Структура, полиморфные модификации, физико-химические свойства кварца. Области применения кристаллов. Выращивание крупных монокристаллов кварца гидротермальным методом. Технологические параметры, оказывающие наибольшее влияние на скорость роста и качество монокристаллов.
  19. Классификация органических материалов для электронной техники. Материалы для органических светоизлучающих диодных структур (ОСИД).



20. Монокристаллы ниобата бария-натрия и ниобата бария-стронция как электрооптические и фоторефрактивные материалы: физико-химические свойства, структура полиморфных модификаций.
21. Ферриты со структурой шпинели, граната, перовскита и гексаплумбита. Би- и полиферриты. Основные методы получения кристаллов ферритов. Основные области применения ферритов. Физико-химические характеристики и методы получения монокристаллов железо-иттриевого граната. Дефекты в кристаллах. Получение монокристаллических эпитаксиальных пленок железо-иттриевого граната.
22. Корунд как важнейший функциональный и подложечный монокристалл. Основные физико-химические свойства, структура. Выращивание кристаллов  $Al_2O_3$  методами Чохральского и Багдасарова, их достоинства и недостатки применительно к технологии корунда. Проблема тигельного материала. Дефекты в кристаллах, методы их контроля и способы устранения.
23. Получение очень крупных кристаллов корунда методом ГОИ. Получение кристаллов различных форм методом Степанова. Дефекты в кристаллах, методы их контроля и способы устранения.
24. Фианит, его основные свойства и сферы применения. Структурные модификации и способы их стабилизации, ЧСЦ. Выращивание кристаллов методом холодного контейнера.
25. Лазерные материалы со структурой граната. Иттрий-алюминиевый гранат: структура, важнейшие физические свойства. Диаграмма плавкости и факторы, благоприятствующие кристаллизации гранатовой фазы. Методы выращивания, характерные ростовые дефекты и методы борьбы с ними.
26. Лазерная керамика на основе иттрий-алюминиевого граната. Термодиффузионное получение композитных активных элементов.
27. Разупорядоченные кристаллические матрицы для редкоземельных ионов.
28. Лазерные стекла и волокна. Неодимовый лазер на стекле, иттербиевые волоконные лазеры.
29. Лазерные кристаллы, легированные переходными 3d-ионами ( $Ti^{3+}:Al_2O_3$ ,  $Cr^{3+}:BeAl_2O_4$ ,  $Cr^{4+}:Y_3Al_5O_{12}$ ,  $Cr^{4+}:Mg_2SiO_4$ ). Проблемы управления зарядовым состоянием ионов-активаторов.
30. Лазерные кристаллы фторидов: общие отличительные особенности физико-химических и спектрально-люминесцентных свойств, преимущества и недостатки по сравнению с оксидными кристаллами. Фторидная лазерная керамика и нано-стеклокерамика.



### Рекомендуемая основная литература:

1. А.В. Глазачев Физические основы электроники [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Глазачев, В.П. Петрович. — Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2013. — 208 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/45131>. — Загл. с экрана.
2. Шаскольская М. П. Кристаллография: учебное пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1984. - 376 с.
3. Майер А. А. Физическая химия твердого тела. Кристаллооптика : учебное пособие. - М. : МХТИ, 1984. - 84 с : ил. - Библиогр.: с. 83.
4. В. П. Зломанов, И. Х. Аветисов, Е. Н. Можевитина. Физическая химия твердого тела. Р–Т–х диаграммы фазовых равновесий. Учебное пособие, М., РХТУ, 2019, 184 с.
5. Ковтуненко П.В. Физическая химия твердого тела. Кристаллы с дефектами.: учеб-ник для хим.-технол. спец. М.: Высшая школа, 1993. 352 с.
6. О.Б. Петрова, И.В. Степанова. Физическая электроника и электронные приборы. Лабораторный практикум и пособие по решению задач. : Учебное пособие. М.: РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2020. 152с.
7. А.Ю. Зиновьев, А.Г. Чередниченко, И.Х. Аветисов Технология органических электролюминесцентных устройств. Теоретические основы и материалы. Учебное пособие. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2010. 62с.
8. А.Ю. Зиновьев, И.Х. Аветисов, А.Г. Чередниченко Технология органических электролюминесцентных устройств. Гетероструктуры. Учебное пособие. М.: РХТУ им .Д.И. Менделеева, 2011. 63с.
9. А.Ю. Зиновьев, А.Г. Чередниченко, И.Х. Аветисов Технология органических электролюминесцентных устройств. Технологические процессы. Учебное пособие. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2012. 64с.
10. Н.Г. Горашенко, О.Б. Петрова, И.В. Степанова. Методы исследования материалов электронной техники и наноматериалов. Лабораторный практикум: учеб. пособие. – М. : РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2012. – 94 с.
11. А. Д. Барканов, Р. И. Аветисов, А. В. Хомяков, И. Х. Аветисов. Технология вакуумных производств. Теоретические основы: учеб. пособие. – М. : РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2022. – 104 с.
12. А. Д. Барканов, Р. И. Аветисов, А. В. Хомяков, И. Х. Аветисов, И. В. Степанова. Технология вакуумных производств. Вакуумное оборудование: учеб. пособи. – М. : РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2022. – 94 с.

### Дополнительная литература:

1. Высокочистые вещества. Коллектив авторов. М., Научный мир, 2018, 996 с.
2. Минералогия и кристаллография. Практические вопросы для аудиторных занятий и самостоятельной подготовки [Текст] : учебно-методическое пособие / сост. О. П. Барина. - М. : РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2017. - 58 с.



3. В.П. Зломанов Фазовые равновесия. Химия дефектов в кристалле. Учебное пособие, М.: МГУ, 2011, 114с.
4. Василенко О.А. Оптические явления в твердом теле: конспект лекций: Учеб. пособие М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2004. – 136 с.
5. Терехов В.А. Задачник по электронным приборам: Учебное пособие. – Санкт-Петербург: Лань, 2003. – 276 с.
6. Пасынков, В.В. Полупроводниковые приборы [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Пасынков, Л.К. Чиркин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2009. — 480 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/300>.
7. Е.П. Шешин. Вакуумные технологии. Долгопрудный, Издательский дом «Интеллект», 2009 - 504 с.
8. О.П.Федоров. Процессы роста кристаллов: кинетика, формообразование, неоднородности. Наукова думка, Киев, 2010, 208 с.
9. А.А.Блистанов. Кристаллы квантовой и нелинейной оптики. Учебное пособие для вузов.- М.: «МИСИС» 2000.- 432 стр.
10. Выращивание кристаллов и волокон из расплава. Под ред. Ц. Фукуды, П. Рудольфа, С. Уды. Пер. с англ., М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009, 368 с.
11. Ю.С. Кузьминов, Е.Е.Ломонова, В.В.Осико. Тугоплавкие материалы из холодного тигля. М., Наука, 2004. 370с.
12. Старосельский В.И. Физика полупроводниковых приборов микроэлектроники. Высшее образование, Юрайт-Издат., 2009.